	фармат	Зана	<i>No3.</i>	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Перв. примен					<u>Документация</u>		
				ИУ3.02.61.01.001 ЭЗ	Схема электрическая		
					принципиальная		
H	╁			<i>NY3.02.61.01.001 32</i>	Схема электрическая		
					ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ		
прав. №					Конденсаторы		
ſυ				C1-C3, C5	0.1 MKΦ X7R 25B 10% 10603,	4	
				,	CGA3E2X7R1E104K080AA		
				<u>C4</u>	10 мкФ, X5R 25 B, 10%, 0603	1	
					GRM188R61E106KA73D		
<u>i</u>		Ш		<i>C5, C6</i>	0.01мкФ X7R 25B 10% 0402,	2	
iarapuntani T	4_				GRM155R71E103KA01D		
.е прила дата					Резисторы		
лостоя оселу Подп. и дат				R2, R5, R9, R12	1 Bm, 15727, 100 Om, 5%	4	
100				R6	1 Вт, 207, 120 Ом, 1%	1	
ληλουπον Ομόπ.				<i>R7</i>	0.25Bm, MF-25, 620 Om, 1%	1	
No du				R4, R11	0.05Вт, SMD, 1.04 кОм, 0.1%	2	
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110				R3, R10	0.05Bm, TH, 437 Om, 0.1%	2	
i No				R1, R8	0.05Bm, 19061, 200 0m, 5%	2	
M. UHC							
Взам.	╁				Микросхемы		
D1 D1	\vdash	\Box		 DD3	CD4013BD	1	
и дата				DA2, DA5	TL431	2	
Подп. и					ИУЗ.02.61.01.001 П		
7. S.		1. /Ιυς. 3ραδ.		№ докцм. Подп. Дата агян Б.А		/lucm	Листов
и песто уга этеити адмат « гого стота песто приятиромния, Инв. № подл. — Подп. и дата — Взам. инв. № Инв. № дубл.	Пров. Левиев Д.О.					1	2
< _ ` _	9111	1B.			<u> </u>	ЭМОЛЭ	A4

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				DA3	TLC555CP	1	
				DD1.1, DD1.2	SN74L VC1G08DB VR	2	
				DD2.1, DD2.2	SN74ACOOD	2	
					Литий-ионные аккумуляторы		
				GB1, GB2	LT-LFP 72	2	
					Транзисторы		
				VT1, VT2, VT9, VT10	BMS3003-1E	4	
				VT7, VT8, VT15, VT16	2SK3070L	4	
				VT3, VT5, VT11, VT13	BCX53	4	
				VT4, VT6, VT12, VT14	BCX56	4	
					Оптоизоляторы		
i i				DA1, DA4	TCET1100	2	
	Ш						
של ש							
у дат							
1 .upu							
2							
.тұт							
No di							
MHB.							
No							
инв.							
ЗДМ.							
7	Ш						
ата	Щ						
. U Ā							
Подп. и б							
	Ш						
подл.							
g. No			T		ИУЗ.02.61.01.001 ПЭЗ		Лис
MH	Изм.	1.		№ докцм. Подп. Дата гиспользования Копира		<i>'</i>	Ź